		Зона	Поз. обозначе– ние	Кол.	Примечание			
Перв. примен.	3AECH.464512.003		BQ1 BQ2	Кварцевый резонатор 8 МГц SMD05032C4 SDE Кварцевый резонатор ABS07W-32.768KHZ Abracon <u>Конденсаторы</u>	1 1			
Cnpaß. Nº			C1 C2 C3 C4, C5 C6 C7 – C12 C13	1 1 1 2 1 6				
Подп. и дата			C14 C15 C16 C17, C18 C19, C20 C21 – C23 C24	1 1 2 2 3 1				
Инв. № дубл.			C25 C26	1				
Взам. инв. №								
Подп. и дата		Изм.	/lucm № 0	ЭАЕСН.464512.	003	3ПЭЗ		
Инв. № подл.	Разраб. Пятиренко Пров. Богданов — устройства Н.контр. Утв. Алексеев Плата оконечного устройства Перечень элементов					Лист Листов 1 7		

Зона	Поз. обозначе– ние	Наименование	Кол.	Примечание
	C27	2,2 мкФ±10% 10 B X7R 0603 GRM188R71A225KE15J	1	
	C28	2,2 MKΦ±10% 10 B X7K 0603 GRM188R71E105KA12D	1 1	
			+	
	C29	0,1 MKΦ±10% 50 B X7R 0603 GRM188R71H104KA93D	1	
	C30	10 MKΦ±20% 6,3 B X5R 0603 GRM188R60J106ME84D		
	C31	0,1 MKΦ±10% 50 B X7R 0603 GRM188R71H104KA93D	1 1	
	C32	0,22 MKΦ±10% 50 B X7R 0603 GRM188R71H224KAC4D		
		0,1 мкФ±10% 50 B X7R 0603 GRM188R71H104KA93D	8	
	C41	10 мкФ±10% 16 В "A" TAJA106K016RNJ	1	
	C42	0,1 мкФ±10% 50 B X7R 0603 GRM188R71H104KA93D	1	
	C43	4,7 мкФ±10% 16 B X7R 0603 GRM188Z71C475KE21D	1	
	C44	1 мкФ±10% 25 В X7R 0603 GRM188R71E105KA12D	1	
	C45	10нФ±10% 100 В X7R 0603 GRM188R72A103KA01J	1	
	C46	0,1 мкФ±10% 50 В X7R 0603 GRM188R71H104KA93D	1	
	C47	10 nФ±5% 50 B NPO 0603 GRM1885C1H100JA01J	1	
	C48	22 мкФ±20% 10 B X7R 1206 GRM31CR71A226ME15L	1	
	C49	4,7 мкФ±10% 16 В X7R 0603 GRM188Z71C475KE21D	1	
	C50	10 мкФ±20% 6,3 В X5R 0603 GRM188R60J106ME84D	1	
	C51	47 нФ±10% 16 В X7R 0603 GCJ188R71C473KA01D	1	
	C52	10 мкФ±20% 6,3 В X5R 0603 GRM188R60J106ME84D	1	
	C53	1 мкФ±10% 25 В X7R 0603 GRM188R71E105KA12D	1	
	C54, C55	22 ΜΚΦ±20% 10 B X7R 1206 GRM31CR71A226ME15L	2	
	C56 – C69	0,1 мкФ±10% 50 B X7R 0603 GRM188R71H104KA93D	14	
-	C70	2,2 нФ±1% 50 В NPO 0603 GCM1885C1H332FA16D	1	
	C71	1,5 нФ±1% 50 В NPO 0603 GRM1885C1H152FA01D	1	
\rightarrow	C72	0,1 мкΦ±10% 50 B X7R 0603 GRM188R71H104KA93D	1	
\dashv		,	+ +	
\dashv		<u>Микросхемы</u>	++	
\dashv		<u>г ішкроелены</u>		
	DA1	LTC2064HMS8 (MSOP–8) Analog Devices		
	DA2	ST1SO6A (DFN6D) ST Microelectronics		
	DINE	טר וסטא וטו אסטן סדי דווכו טבנבבוז טווובס	+ +	
井			0.002	
1011	/lucm № ð	ЭАЕСН.464512 окум. Подп. Дата	2.UU31	133 F

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз. обознач ние	2- Наименование	Кол.	Примечание
DA3	ADS1220IPW (TSSOP—16) Texas Instruments	1	
DA4	MAX6102EUR+ (SOT-23) Maxim	1	
DA5 – DA	10 STMPS2151STR (SOT-23-5) ST Microelectronics	6	
DA11, DA	12 DRV5032FA (SOT–23) Texas Instruments	2	
DA13	LT8609AEDDM (SON-10) Analog Devices	1	
DA14, D	A15 TPS25944A (WQFN-20) Texas Instruments	2	
DA16	BQ25887 (VQFN-24) Texas Instruments	1	
DD1	SN65HVD234D (SOIC-8) Texas Instruments	1	
DD2	STM32F207VCT6 (LQFP–100) ST Microelectronics	1	
DD3, DD	4 ADM3485 (SOIC—8) Analog Devices	2	
DD5	CAM-M8Q Ublox	1	
DD6	LIS3DH (LGA–16) ST Microelectronics	1	
DD7	W25Q64FVSSIG (SOIC-8) Winbond Electronics	1	
FB1, FB2	? Дроссель подавления импульсных помех	2	
	BLM18PG121SN1D 0603 Murata		
L1	Катушка индуктивности 6,8 мкГн	1	
	SRR0604-6R8ML Bourns		
L2	Катушка индуктивности 2,2 мкГн	1	
	IHLP2525CZER2R2MA1 Vishay		
L3	Катушка индуктивности 1 мкГн	1	
	IHLP2525CZER1R0M01 Vishay		
	Резисторы		
			
R1	4,7 кОм ±1% 0.1 Вт 0603 RC0603FR-074K7L	1	
R2	110 Ом ±5% 0.062 Вm САТ16-111J4	1	
<u> </u>			Т
Изм. Лист	P докум. Подп. Дата ЭАЕСН.4645	512.0031	733

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Зона	Поз. обозначе– ние	Наименование	Кол.	Примечание
	רח	17.0 F0/ 00/2 D CAT// 170 U	1	
	R3	47 Om ±5% 0.062 Bm CAT16-470J4	1	
	R4	0 0m ±5% 0.1 Bm 0603 RC0603JR-070RL	1	
	R5	10 κ0m ±5% 0.1 Bm 0603 RC0603JR-0710KL	1	
	R6	0 0m ±5% 0.1 Bm 0603 RC0603JR-070RL	1	
	R7	30,1 кОм ±1% 0.1 Вm 0603 RC0603FR-0730K1L	1 -	
	R8 – R12	10 кОм ±5% 0.1 Вт 0603 RC0603JR-0710KL	5	
	R13	15 кОм ±5% 0.1 Вт 0603 RC0603JR-0715KL	1	
	R14	47 κOm ±5% 0.1 Bm 0603 RC0603JR-0747KL	1	
	R15	47 Ом ±5% 0.1 Вm 0603 RC0603JR-0747RL	1	
	R16, R17	0 0м ±5% 0.25 Bm 1206 RC1206JR-070RL	2	
	R18 – R20	47 кОм ±5% 0.1 Вт 0603 RC0603JR-0747KL	3	
	R21 – R23	120 Ом ±5% 0.25 Вт 1206 RC1206JR-13120RL	3	
	R24, R25	47 кОм ±5% 0.1 Вт 0603 RC0603JR-0747KL	2	
	R26	0 Ом ±5% 0.1 Вт 0603 RC0603JR-070RL	1	
	R27	47 кОм ±5% 0.1 Вт 0603 RC0603JR-0747KL	1	
	R28 – R31	10 кОм ±5% 0.1 Вт 0603 RC0603JR-0710KL	4	
	R32, R33	2,2 кОм ±5% 0.1 Bm 0603 RC0603JR-072K2L	2	
	R34	33 Ом ±5% 0.1 Вт 0603 RC0603JR-0733RL	1	
	R35	10 кОм ±5% 0.1 Вт 0603 RC0603JR-0710KL	1	
	R36	15 кОм ±5% 0.1 Вт 0603 RC0603JR-0715KL	1	
	R37	0 0м ±5% 0.1 Bm 0603 RC0603JR-070RL	1	
	R38	33 Om ±5% O.1 Bm O6O3 RCO6O3JR-O733RL	1	
	R39	475 кОм ±1% 0.1 Вт 0603 RC0603FR-07475KL	1	
	R40	107 кОм ±0,5% 0.1 Вт 0603 RT0603DRE07107KL	1	
	R41	18,2 кОм ±1% 0.1 Вm 0603 RC0603FR-1018K2L	1	
	R42	187 кОм ±1% 0.1 Вт 0603 RC0603FR-07187KL	1	
	R43	1 MOm ±5% 0.1 Bm 0603 RC0603JR-071ML		
	R44	100 кОм ±1% 0.1 Вт 0603 RC0603FR-07100KL	1 1	
		10 кОм ±5% 0.1 Вт 0603 RC0603JR-0710KL	3	
	R48	383 Om ±1% 0.1 Bm 0603 RC0603FR-07383RL	1	
	11/4/	אורחר / ח_או ורחחחאו רחחח וווים דים 170 הסר		
	/lucm № ð	ЭАЕСН.464512.	007	3ПЭЗ

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание				
D/ O	D/O 200 0v .F9/ 0.1 Pm 0/O2 DC0/O2 ID 07200DI						
R49	300 Om ±5% 0.1 Bm 0603 RC0603JR-07300RL						
R50	10 KOM EWTF03-103H3T-N 0603 Eway Technology						
R51	30,1 кОм ±1% 0.1 Вm 0603 RC0603FR-0730K1L	1					
R52							
R53	R53						
R54 – R56	10 кОм ±5% 0.1 Bm 0603 RC0603JR-0710KL	3					
R57	35,7 кОм ±1% 0.1 Вт 0603 RT0603FRE0735K7L	1					
R58	10 кОм ±5% 0.1 Вт 0603 RC0603JR-0710KL	1					
R59	42,2 кОм ±1% 0.1 Вт 0603 RC0603FR-0742K2L	1 1					
R60	10 кОм ±5% 0.1 Bm 0603 RC0603JR-0710KL	1					
R61	158 кОм ±1% 0.1 Вт 0603 RC0603FR-07158KL	1					
R62	24,9 кОм ±1% 0.1 Вт 0603 RC0603FR-0724K9L	1					
R63	475 кОм ±1% 0.1 Вт 0603 RC0603FR-07475KL	1					
R64	10 кОм ±5% 0.1 Bm 0603 RC0603JR-0710KL	1					
R65							
R66	10 кОм ±5% 0.1 Bm 0603 RC0603JR-0710KL	1					
R67	1,5 кОм ±5% 0.1 Вт 0603 RC0603JR-071K5L	1					
SA1	Переключатель SMTS-102-A2	1					
	Диоды						
VD1	Защитный диод NUP2105LT1G ON Semiconductor	1					
VD2	Chemoduod FYLS-3528RGBC Foryard	1					
VD3	Диод Шоттки РМЕG1020EJ Nexperia	1					
	Транзисторы						
	· Farragemaka.	++					
VT1	IRLML2030TRPBF (SOT-23) Infineon Technologies	1					
VT2	IRLML9303TRPBF (SOT-23) Infineon Technologies	1					
<u> </u>	3AECH.4645°	12 002	רבד /				

Подп. и дата

Инв. № подл.

		Зана	Поз. обозначе– ние	Наименование		Примечание
			X1	Держатель SIM-карты 475531001 Molex	1	
			X2	Батарейный отсек STM18650–2 E–Fire	1	
			X3 – X7	Контактное поле	5	
				Изделия соединительные		
			XP1	Вилка штыревая PLS—5 Connfly	1	
			XP2	Вилка штыревая PLS—2 Connfly	1	
			XS1	Разъем М.2 2199230–5 TE Connectivity	1	
			XS2 – XS4	Разъем CI1105M1V Cvilux	3	
			XS5, XS6	2		
			XS7	Разъем вертикальный USB3145—30—1—A GCT	1	
			XS8	Разъем CI1110M1V Cvilux	1	
g g			Z1	Фильтр NFE61PT472C1H9L 2606	1	
и дата						
Подп. и						
δл.						
Инв. № дубл.						
MHB.						
2	\neg					
Взам. инв.						
Взам						
П	\neg					
Jama	-					
Подп. и дата						
\mathbb{H}	\dashv					
Инв. № подл.	ļ		<u> </u>			
₽	-			3AECH.464512.		$\Pi = \frac{1}{2}$
Ź	Ī	/Ізм.	/lucm № ð	окум. Подп. Дата		

		Лист регистрации изменений								
			Номера листов (страниц)					Входящи <u>й</u> №		
	иєМ		заме- ненных	новых	аннули– рованных	Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	и дата и дата	Подп.	Дата
П										
аша										
Подп. и дата										
јðл.										
Инв. № дубл.										
H	_									
Взам. инв. №										
Взам.										
П										
Подп. и дата										
Nodn.										
подл.										1 -
Инв. № подл.						ЭА	ECH.40	54512.0	03ПЭ3	/lucm 7
	Изм.	/lucm N	р докум.	Подп.	Дата				Φ	